В.В. ШЕПЕЛЕВИЧ¹, А.В. МАКАРЕВИЧ¹, П.И. РОПОТ²

¹МГПУ им. И.П. Шамякина (г. Мозырь, Беларусь) ²Институт физики НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь)

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ОТ ТОЛЩИНЫ ФОТОРЕФРАКТИВНОГО ПЬЕЗОКРИСТАЛЛА Ві₁₂ТіО₂₀

В связи с возможностью практического применения динамических голограмм, записанных в фоторефрактивных кристаллах, для усиления оптических пучков [1] в фильтрах новизны [2], а также в других важных приложениях и устройствах представляет интерес экспериментальное изучение коэффициента усиления предметной световой волны от толщины используемого кристаллического образца.

Для проведения этого исследования была применена трапециевидная геометрия перекрытия в кристалле световых пучков с плоским волновым фронтом из работ [3–5], в которых впервые были представлены экспериментальные и теоретические результаты по изучению коэффициента усиления предметной световой волны при двухволновом смешивании от толщины фоторефрактивных кристаллов семейства силленита Bi₁₂SiO₂₀ (BSO), Bi₁₂GeO₂₀ (BGO) и Bi₁₂TiO₂₀ (BTO). Однако в этих работах проведение экспериментальных исследований осуществлялось только для двух взаимно перпендикулярных пространственных ориентаций кристаллов, при которых обратный пьезоэлектрический и фотоупругий эффекты (далее сокращенно «пьезоэффект») не проявляются ($\vec{K} \parallel [001]$, где \vec{K} – вектор голографической решетки) или их влиянием можно пренебречь ($\vec{K} \perp [001]$) [6]. Поэтому здесь мы демонстрируем результаты подобных исследований для кристалла ВТО в случае, когда оба вышеуказанных

условия не выполняются, и при теоретической интерпретации экспериментальных данных обязательно учитываем пьезоэффект [6–8].

В эксперименте использовался кристаллический образец ВТО среза (110) с толщиной d, равной 7.7 мм. Ориентационный угол кристалла θ составлял 17°. Исследование коэффициента усиления предметной световой волны осуществлялось для четырех азимутов линейной поляризации взаимодействующих в кристалле опорного и предметного световых пучков $\Psi_0 = 0$, 45°, 90° и 135°. Угол Брэгга φ_0 вне кристалла составлял 25°. Отношение интенсивностей предметного и опорного световых пучков Is/I_R было равно 0.26. Коэффициент усиления предметной световой волны определялся как $\gamma(d) = I_S(d)/I_{S0}(d)$, где I_S(d) и I_{S0}(d) – интенсивности предметного пучка на выходе из кристалла толщиной d в присутствии и в отсутствие опорного пучка (пучка накачки) соответственно.

Теоретическая интерпретация экспериментальных данных проводилась на основании системы уравнений связанных волн из работы [9], в которой было показано, что в этом представителе силленитов формируются смешанные (амплитудно-фазовые) голографические решетки. При расчетах использованы параметры кристалла ВТО из [9; 10]. Направления отсчета ориентационного угла кристалла и азимутов линейной поляризации световых волн представлены в [8]. Амплитуда напряженности электрического поля пространственного заряда E_{sc} выбиралась равной 1.395 кВ/см и соответствовала наилучшей корреляции теории и экспериментальных данных.

Результаты выполненных экспериментальных и теоретических исследований, представлены на рисуке, из которого видно, что в случае пренебрежения пьезоэффектом экспериментальные данные и результаты теоретического анализа имеют хорошо наблюдаемое расхождение при $\Psi_0 = 0$, 90° (рисунок а)) и 135° (рисунок б)), которое может быть устранено путем «включения» в теоретической модели пьезоэффекта.

Что касается азимута линейной поляризации $\Psi_0 = 45^\circ$, то в этом случае при выбранных условиях проведения эксперимента расхождение теоретических кривых, полученных с учётом и без учёта пьезоэффекта, проявляется незначительно.

Следует отметить, что на рисунках а) и б) вертикальной штриховой линией отмечена граница между областью, в которой взаимодействие световых волн происходило при различных значениях эффективной толщины кристалла $0 \le d \le 7.7$ мм, и областью, в которой взаимодействие световых пучков происходило при фиксированной толщине кристалла $d_0 = 7.7$ мм (см. также [11; 12]).



Рисунок – Зависимость коэффициента усиления предметной световой волны γ от толщины d кристалла BTO среза ($\overline{110}$) с фиксированной толщиной d₀ = 7.7 мм при ориентационном угле $\theta = 17^{\circ}$: а) при $\Psi_0 = 0$ и 90°, б) при $\Psi_0 = 45^{\circ}$ и 135°; черная сплошная линия – зависимость γ (d) с учетом пьезоэффекта, черная пунктирная линия – зависимость γ (d) без учета пьезоэффекта, серая (ломаная) линия – экспериментально полученная зависимость γ (d)

Таким образом, выполнено экспериментальное исследование зависимости коэффициента усиления предметной световой волны от толщины кристалла ВТО с использованием одного кристаллического образца среза ($\overline{110}$) с фиксированной толщиной 7.7 мм. Дана теоретическая интерпретация экспериментальных результатов на основании системы уравнений связанных волн, принимающей во внимание возможность формирования смешанных голограмм в этом кристалле, а также обратный пьезоэлектрический и фотоупругий эффекты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Analysis of output beam polarization in higher-order self diffraction via two-wave mixing in BSO crystal / Katyal N. [et al.] // Optik. – 2013. – Vol. 124, № 1. – P. 8–12.

2. Stepanov, S.I. Applications of photorefractive crystals / S.I. Stepanov // Rep. Prog. Phys. – 1994. – Vol. 57, № 1. – P. 39–116.

3. Dynamic holography with none plane waves in sillenites / E. Shamonina [et al.] // Opt. Quant. Electron. – 1996. – Vol. 28. – P. 25–42.

4. Investigation of two-wave mixing in arbitrary oriented sillenite crystals / E. Shamonina [et al.] // Appl. Phys. B. – 1997. – Vol. 64. – P. 49–56.

5. Optical activity in photorefractive $Bi_{12}TiO_{20}$ / E. Shamonina [et al.] // Opt. Comm. – 1998. – Vol. 146, No 1–6. – P. 62–68.

6. Gain optimization with respect to the thickness of a sillenite crystal / V.V. Shepelevich [et al.] // Appl. Phys. B. – Vol. 68, – P. 923–929.

7. Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах: монография / С.М. Шандаров [и др.]. – Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 242 с.

8. Шепелевич, В.В. Голография в фоторефрактивных оптически активных кристаллах: монография / В.В. Шепелевич. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 254 с.

9. Шепелевич, В.В. Смешанные пропускающие голограммы в фоторефрактивном пьезокристалле Bi₁₂TiO₂₀ / В.В. Шепелевич, А.В. Макаревич, С.М. Шандаров // Письма в ЖТФ. – 2014. – Т. 40, № 22. – С. 83–89.

10. Diffusion recording in photorefractive sillenite crystals: an analytical approach for engineering purposes / E. Shamonina [et al.] // Opt. Comm. – 2000. – Vol. 180, №1–3. – P. 183–190.

11. Экспериментальное исследование ориентационной зависимости дифракционной эффективности пропускающих голограмм от толщины кристалла Bi₁₂SiO₂₀ / А.В. Макаревич [и др.] // Письма в ЖТФ. – 2015. – Т. 41, № 19. – С. 46–54.

12. Экспериментальное исследование зависимости дифракционной эффективности фоторефрактивных голограмм от толщины образца и ориентационного угла в кристалле Bi₁₂SiO₂₀ среза (110) // В.В. Шепелевич [и др.] / Известия вузов. Физика. – 2015. – Т. 28, № 10. – С. 74–79.